

嵌入式解決方案



PCIe M.2 SSDs

MTE352T

創見單面顆粒MTE352T固態硬碟搭載PCIe Gen 3 x2介面，符合最新NVMe 1.3規範，帶來前所未有的傳輸效能；採用最新一代3D NAND技術，可堆疊高達96層快閃記憶體，相較於前一代3D NAND的64層堆疊，大幅突破單位密度上限，達到更高的儲存效益。創見MTE352T固態硬碟具備3K抹寫次數的耐用度等級，30μ"金手指厚金鍍層PCB及邊緣補強(Corner Bond)工藝亦提供優異可靠的性能。此外，MTE352T具備類寬溫(-20°C~75°C)特性，完美滿足任務密集型應用的需求。

硬體特點

- 全系列產品搭載邊緣補強技術(Corner Bond)，保護關鍵元件
- 搭載PCIe Gen 3 x2 介面
- 耐用度為3K次抹寫週期 (P/E cycles)
- 30μ"金手指厚金鍍工藝
- 支援於類寬溫條件(-20°C到75°C)下運作

訂購資訊

128GB	TS128GMTE352T
256GB	TS256GMTE352T
512GB	TS512GMTE352T

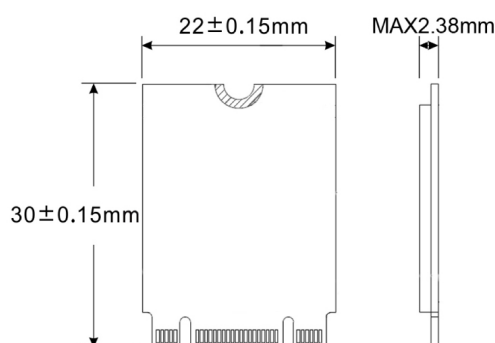
韌體特點

- 內建SLC caching技術
- 支援NVM指令
- 內建LDPC ECC自動糾錯功能
- 支援垃圾資料回收機制
- 動態熱能管理機制

規格

外觀	尺寸	30 mm x 22 mm x 2.38 mm (1.18" x 0.87" x 0.08")
	重量	4 g (0.14 oz)
	外觀尺寸	M.2
	M.2規格	2230-S3-B-M (單面打件)
介面	匯流排介面	NVMe PCIe Gen3 x2
存儲	Flash類型	3D快閃記憶體
	容量	128 GB / 256 GB / 512 GB
操作環境	工作電壓	3.3V±5%
	工作溫度	類寬溫 -20°C (-4°F) ~ 75°C (167°F)
	儲存溫度	-55°C (-67°F) ~ 85°C (185°F)
	濕度	5% ~ 95%
	耐衝擊	1500 G, 0.5 ms, 3 axis
	耐振動 (操作中)	20 G (peak-to-peak), 7 Hz ~ 2000 Hz (frequency)
電量	耗電量 (操作中)	3.12 瓦
	耗電量 (IDLE)	0.36 瓦
效能	連續讀寫速度 (CrystalDiskMark)	讀取: 高達 1,700 MB/s 寫入: 高達 1,000 MB/s
	4K隨機讀寫速度 (IOmeter)	讀取: 高達 150,000 IOPS 寫入: 高達 230,000 IOPS
	平均故障間隔 (MTBF)	3,000,000 小時
	寫入兆位元組 (TBW)	高達 1,080 TBW
	每日全碟寫入次數 (DWPD)	2.0 (3 年)
保固	安規認證	CE / FCC / BSMI
	保固	三年有限保固

機構尺寸



產品規格如有變更，恕不另行通知。外觀圖片僅供參考，請以實際產品為準。總可用容量會因操作環境而異。由於工業應用的多元性及複雜性，創見無法保證本產品完全相容於所有平台與使用情境。如有特殊需求及操作環境，建議您購買前先與我們聯繫。